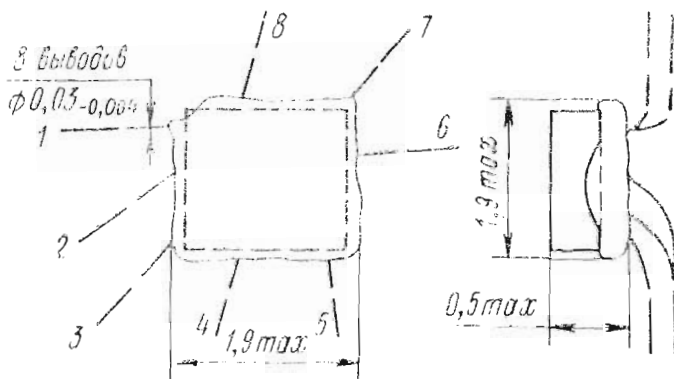


# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ К740

## Общие данные

Микросхемы имеют бескорпусное исполнение.

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 0,006 г

Нумерация выводов показана условно.

### ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц . . . . .	1—500
амплитуда ускорения, м/с <sup>2</sup> (g) . . . . .	100 (10)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с <sup>2</sup> (g) . . . . .	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	0,1—2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с <sup>2</sup> (g) . . . . .	750 (75)
длительность действия ударного ускорения, мс	1—6

Линейное ускорение, м/с<sup>2</sup> (g) . . . . . 500 (50)

Пониженная рабочая температура среды, °С . . . . . минус 45

Повышенная рабочая температура среды, °С . . . . . 85

Изменения температуры среды, °С . . . . . от минус 45 до +85

## НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка *, ч . . . . .	20 000
Срок сохраняемости *, лет . . . . .	15

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ 11 073.920—84 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 200 В.

После извлечения микросхем из герметической или влагозащитной упаковки в период производства ГС (в срок не более 60 сут.) до герметизации микросхемы должны находиться в следующих условиях:

допустимая концентрация аэрозолей в производственных помещениях — 3500 част./л размером 0,5 мкм и более;

точность поддержания температуры  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ;

относительная влажность  $50 \pm 10\%$ .

При применении и эксплуатации микросхем в составе ГС должны быть приняты меры по защите от статического электричества. При монтаже в гибридную микросхему, узлы и блоки аппаратуры не разрешается изгиб выводов с радиусом не менее 0,2 мм и соприкосновение вывода с кристаллом.

Не допускается наличие электрического контакта между кристаллом и токоведущими элементами подложки, на которой монтируется микросхема. В качестве материалов подложки рекомендуются ситалл и поликор.

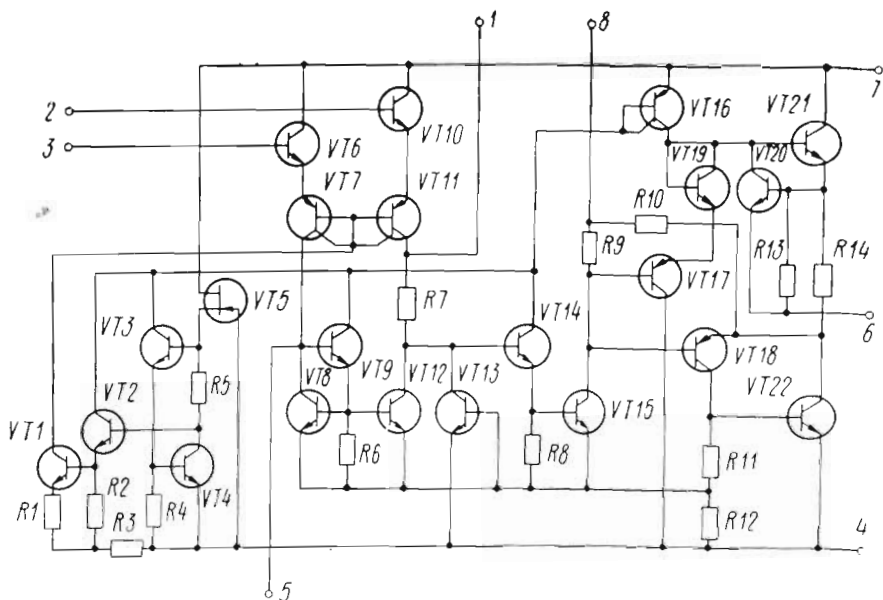
Приклейку микросхем к подложке производят защитным покрытием вверх. Толщина клея под микросхемой не должна превышать 0,05 мм и не должна иметь пустот.

Перенос микросхемы из тары к месту склеивания осуществляют пинцетом за конец вывода (не менее 5 мм от края кристалла). Допускается прижатие микросхемы к месту склеивания инструментом, исключающим повреждение покрытия и выводов, усилием не более 50 гс.

Выводы микросхем при монтаже рекомендуется присоединять сваркой. Минимальное расстояние сварки от края кристалла — 1 мм. Выводы длиннее 3 мм закреплять лаками (компаундами). При монтаже микросхем должны быть приняты меры, переключающие напряжение выводов и перегрев кристалла микросхем с защитным покрытием.

\* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



1 — блокировка, коррекция  
 2 — инвертирующий вход  
 3 — неинвертирующий вход  
 4 — минус 15 В

5 — блокировка  
 6 — выход  
 7 — 15 В  
 8 — коррекция

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 10^\circ\text{C}$ )

Напряжение питания, В:

$U_{n1}$  . . . . .  $15 \pm 10\%$   
 $U_{n2}$  . . . . . минус  $15 \pm 10\%$

Входной ток, мкА, не более . . . . . 1,5

Разность входных токов, мкА, не более . . . . . 0,5

Напряжение смещения нуля, мВ, не более . . . . . 7,5

Максимальное выходное напряжение, В, не менее . . . . .  $\pm 10$

Коэффициент усиления напряжения, не менее . . . . .  $20 \cdot 10^3$

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение питания \*, В:

$U_{п1}$		
максимальное . . . . .		16,5
минимальное . . . . .		5
$U_{п2}$		
максимальное . . . . .	минус	16,5
минимальное . . . . .	минус	5
Максимальное входное напряжение, В . . . . .		30
Максимальное синфазное входное напряжение, В . . . . .		$\pm 12^{**}$
Минимальное сопротивление нагрузки, кОм . . . . .		2

\* При симметричном напряжении питания.

\*\*  $U_{п1} = 16,5$  В;  $U_{п2} = -16,5$  В.